مطالعه اثر قطبش و پارامتر شکل روی پاسخ اپتیکی غیرخطی یک مولکول هیبریدی متشکل از یک کوانتم دات نیمرسانا جفت شده با دو نانوذره فلزی: تولید هارمونیک دوم





چکیدہ:

در این مقاله تولید هارمونیک دوم در یک سیستم هیبریدی (ملکول هیبریدی) متشکل از دو نانو ذره بیضوی شکل که با یک کوانتوم دات نیم رسانا جفت می شوند وقتی که سیستم تحت تابش یک میدان لیزر قرار می گود با استفاده از روش ماتریس چگالی بررسی می شود. این میدان اعمال شده قطبشی را برروی کوانتوم دات نیم رسانا و هر دو نانو ذره پلاسمونیک متفاوت ایجاد می کند، و نانوذرات قطیده شده از طریق برهمکنش دوقطبی-دوقطبی با کوانتم دات برهمکنش می کنند. ثابت می شود که تولید هارمونیک دوم قویا به جهت قطبش میدان فرودی و فاکتور شکل نانو ذرات پلاسمونیکی بیضوی کشیده و پخت که با کوانتوم دات جفت می شوند هنگامی که میدان به کار رفته موازی یا عمود بر با محور اصلی سیستم می تابد، بستگی دارد. مطالعه بر هم کنش نور – ماده در چنین مولکول هیبریدی می تواند برای طراحی وسایل نوری مبتنی پر برهم کنش پلاسمون استری کی بیضوی مناسب باشد.

۱. مقدمه

در سالهای اخیر ترکیب نانوذرات فلزی و نیمرسانا با خواص الکتریکی و اپتیکی متفاوت منجر به طراحی یک ساختار ترکیبی(هیبریدی) جدید شده است که ویژگیهای منحصربفرد این سیستمهای نوین باعث شده مطالعه این گونه ساختارهای هیبریدی به موضوع جالبی برای کاربردهای نوری، الکترونیکی و بیولوژیکی تبدیل شود. یکی از مهمترین آنها سیستمهای

هیبریدی متشکل از نقطهٔ کوانتومی نیم رسانا (SQD) او نانو ذرهٔ فلزی (MNP) ^۲ است. این ساختارها امکان مطالعه فیزیک را در وجه مشترک علم مکانیک کلاسیک و کوانتوم میسر کرده و تکنولوژی لازم برای ساخت امکانات کوانتومی را در دسترس قرار داده است [۱–۸]. در حقیقت، پاسخ اپتیکی کوانتوم داتها و نانو ذرههای فلزی به ترتیب اکسیتونها و پلاسمونهای سطحی هستند که زمانی که با هم تزویج می شوند به ظهور حالت هیبریدی منجر خواهد شد که مدهای پلکسایتونی^۳ نام دارد. در سیستمهای هیبریدی مذکور تونل زنی مستقیم بین

⁴ dipole–dipole interaction (DDI)

¹ Semiconductor Quantum Dot

² Metallic Nano Particle

³ Plexcitonic Modes

که میدان کاوشگر (یمپ) نامیده می شود. با اعمال این میدان دو قطبیهایی در کوانتوم دات و نانو ذرهها القا می شود که باعث ایجاد بر هم کنش دوقطبی– دوقطبی بین آنها میشود. فرض می شود کل سیستم در محیطی با ثابت دی الکتریک \mathcal{E}_{evn} قرار $r_{\rm s}$ گرفته است. فرض میکنیم کوانتوم دات نیمرسانا با شعاع و تابع دی الکتریک \mathcal{E}_{s} دارای دو تراز اکسایتونی مجزا است که (1| تراز پایه و (2| تراز برانگیخته است و اختلاف انرژی بین حالتهای انرژی برابر با $\hbar \omega_{12}$ است (شکل ۱ ب). جذب دو فوتون به طور همزمان از ميدان پروب منجر به گذار دوقطبي بین ترازهای <2 → (1 از طریق تراز مجازی می شود. لازم به ذکر است که پایستگی انرژی شرط $\omega_{12} = 2\omega$ را نتیجه میدهد. دو قطبی الکتریکیهای القا شده در کوانتوم دات و نانو **درات** با عث ایجاد میدانهای الکتریکی در اطراف آنها می شود که برهمکنش بین آنها از نوع بر هم کنش دو قطبی – دو قطبی میدان الکتریکی ناشی از دو قطبیهای القا شده در $E^{qd}_{\mathsf{x}ddi}$ كوانتوم دات در محل هر نانو ذره را به ترتيب با $E^{qd}_{\mathsf{1}ddi}$ و نشان میدهیم و میدان الکتریکی ناشی از نانو ذره یک و دو را در محل کوانتوم دات به ترتیب با $E_{ddi}^{mnp_{\star}}$ و $E_{ddi}^{mnp_{\star}}$ نمایش مي دهيم. رابطهٔ مربوط به هر يک از اين ميدان ها به صورت زير است: [۱ و ۲۷].

$$\begin{split} E_{vddi}^{qd} &= \frac{S_{\alpha} P_{qd}}{\mathfrak{r} \pi \varepsilon_h \varepsilon_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}}}, \\ E_{vddi}^{qd} &= \frac{S_{\alpha} P_{qd}}{\mathfrak{r} \pi \varepsilon_h \varepsilon_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}}}, \end{split} \tag{1}$$

$$E_{ddi}^{mnp_{(\mathfrak{r})}} &= \frac{S_{\alpha} P_{mnp_{(\mathfrak{r})}}}{\mathfrak{r} \pi \varepsilon_h \varepsilon_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}}}. \\ \vdots &\vdots \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \vdots &\vdots \\ \vdots &\vdots \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \vdots &\vdots \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \vdots &\vdots \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \vdots &\vdots \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{env} + \varepsilon_h}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} e_{eff} R_{v}^{\mathsf{r}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{env}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{eff}}{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff}} \\ \varepsilon_{eff} &= \frac{\mathfrak{r} \varepsilon_{eff} + \varepsilon_{$$

- که \mathcal{E}_{s} و \mathcal{E}_{s} به ترتیب ثابت دی الکتریک محیط میزبان و کوانتوم دات است.
- ⁵ Second Harmonic Generation
- ⁶ Second Harmonic Generation
- ⁷Sum Frequency Generation
- ⁸ Difference frequency Generation
- ⁹ Third Harmonic Generation
- ¹⁰ Two Photon Absorption
- ¹¹ Optical bistability

MNPو SQD وجود ندارد. با این حال، بخاطر اندر کنش کولنی دور برد، برهم کنش دوقطبی-دوقطبی(DDI)' به وجود می آید که امکان انتقال اطلاعات را فراهم می کند. برای توصیف رفتار نانو ذرات فلزي از مكانيك كلاسيك و براي توصيف رفتار نقطه کوانتومی از مکانیک کوانتومی استفاده می شود به طوریکه در برهم کنش با نور نقطهٔ کوانتومی رفتار کوانتومی و نانوذره فلزی رفتار کلاسیکی را به نمایش میگذارد. علاوه بر این، در برهمکنش تابش میدان فرودی با شدت بالا با این سیستم هیبریدی متشکل از نانوذره پلاسمونیک و نقطه کوانتمی منجر به ظهور يديده هاي اپتيكي غير خطي مانند توليد هماهنگ دوم (SHG) ، توليد جمع فركانسي (SFG) ، توليد تفاضل فركانسي (DFG) ^{*}، توليد هماهنگ سوم(THG) ،جذب دو فوتونی(TPA) ^عو دو است[۹–۱۲]. بعنوان مثال، فرآیند تولید هماهنگ دوم که در آن دو فوتون با بسامد یکسان در نانو ساختار جفت می شوند و یک فوتون با بسامد دو بر آبا از آن ساطع می شود، به علت کاربردهای گسترده ای که دارد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. لازم به ذکر است که شدت یدیده های ایتیکی غیرخطی معمولا خیلی ضعیف است و برای افزایش شدت سگنال تابش شده بایستی اثر پارامترهای سیستم بررسی شوند. براین اساس، در این مقاله اثر قطبش شکل ذره روی شدت هارمونیک تولید شده توسط کوانتم دات بررسی مى شود.

۲. مدل و تئوری مسئله

برای مطالعه اثر قطبش و شکل نانوذره روی شدت هارمونیک تولید شده یک سیستم مطابق شکل ۱ در نظر می گیریم که از سه ذره تشکیل شده است. سیستم مورد نظر ما متشکل ازدو نانو ذره فلزی بیضوی با اندازههای مختلف است که در طرفین کوانتوم دات با فاصلههای مختلف Rو _۲R قرار گرفته است که تحت تابش یک میدان قوی با دامنه E_0 و فرکانس ϖ دامنه



شکل ۱. الف) طرح سیستم هیبریدی مورد مطالعه شامل کوانتوم دات که بین دو نانوذره بیضوی قرار دارد و تحت تاثیر میدان الکتریکی پروب(کاوشگر)قرار دارد.ب)ترازهای انرژی کوانتوم دات و نانو ذرات که برهم کنش دو قطبی–دو قطبی باهم دارند.



شکل ۲. طرح وارهای از نانو ذرهٔ بیضوی با سه محور اصلی b، a وc.

هم چنین c.c. هم چنین $p_{qd} = k_{11} \rho_{11} E_e^{(-i\tau \omega t)} + c.c.$ قطبش غیر خطی کوانتوم دات تحت تاثیر جذب دو فوتونی است[۱۲]. k_{11} و k_{11} ضریب جذب دو فوتونی، ρ_{11} عنصر ماتریس چگالی و c.c. به همیوغ مختلط اشاره دارد. p_{mnp} نیز قطبش نانو ذره است که با میدانهای موثر بر آن متناسب است.

به علت جذب همزمان دو فوتون از موج فرودی پدیده غیر خطی تولید هماهنگ دوم بروز پیدا میکند که میدان ناشی از سیگنالهای آن در اطراف هر ذره به صورت زیر است.

$$E_{shg}^{qd} = \frac{p_{qd}}{(\mathfrak{r}\pi r_s^{\mathfrak{r}} / \mathfrak{r})\mathcal{E}_{env}},$$

$$E_{shg}^{mnp_{(\mathfrak{r})}} = \frac{p_{mnp}}{\pi a_{(\mathfrak{r})}^{\mathfrak{r}} b_{(\mathfrak{r})} \mathcal{E}_{evm}}.$$
(Y)

که r_s^r شعاع کوانتوم دات و $a_{n(r)}$ و $b_{n(r)}^{}$ طول محورهای نانو ذرات بیضوی می باشد. توجه داشته باشید که هر نانو ذره بیضوی در این پروژه دارای دو محور یکسان می باشد که نسبت

به محور سوم می تواند اندازهٔ کمتر یا بیشتری داشته باشد . چنانچه طول دو محور یکسان نسبت به محور سوم کمتر باشد نانو ذره کشیده و اگر بزرگتر باشد نانو ذره پهن شده است. میدانهای الکتریکی موثر بر هر نانو ذره چند قسمت دارد: اول میدان خارجی که به طور مستقیم بر آنها اعمال می شود ، دوم میدانهای دو قطبی و هارمونیک دوم ناشی از کوانتوم دات و قسمت سوم میدانهای دو قطبی و هارمونیک دوم ناشی از نانوذره دیگر می باشد. میدانهای الکتریکی مذکور منجر به ایجاد قطبش در نانو ذره می شوند که رابطه آن تحت تقریب شبه ایستا به صورت زیر می باشد [۱۱]:

$$\begin{split} p_{mnp_{(j)}} &= [\chi_{j}^{(i)}(E_{ddi}^{qd} + E_{shg}^{qd}) + \chi_{j}^{(r)}E_{p}^{r}]e^{-riot}, \quad (j = 1, r) \ (r) \\ &\geq \lambda_{j}^{(r)} \\ &\geq \lambda_{j}^{(r)} \\ &\leq \lambda_{j$$

(4)

$\chi^{(1)} - V$	$\mathcal{E}_{env}(\mathcal{E}_{j}(\omega) - \mathcal{E}_{env})$
$\chi_{(j)} - \mathbf{v}_{(j)}$	$\overline{\mathcal{E}_{env}} + \xi_{a_j,b_j}(\mathcal{E}_j(\omega) - \mathcal{E}_{env}).$

که بیانگر آنست که مقدار پذیرفتاری مرتبه اول متناسب با تابع دی الکتریک وابسته به فرکانس نانو ذرات است، که برای محاسبه آن از مدل درود استفاده می شود. بعلاوه $(\mathcal{W}_{(j)}^{(n)}\chi^{\prime}((\mathcal{O}))_{(j)}^{(n)}\chi$ پذیرفتاری مرتبه دوم است که با مقدار پذیرفتاری مرتبه اول متناسب است. در رابطهٔ مربوط به پذیرفتاری خطی مرتبه اول کمیت فاکتور شکل^۱($\xi_{a,b}$)، دیده می شود که این کمیت وابسته به ویژگیهای هندسی نانوذره است که در ادامه توضیح داده می شود. مورفولوژی نانوذره پلاسمونیک در نظر گرفته شده در این مقاله در شکل ۲ توضیح داده شده است.

مطابق شکل ۲، نانو ذره بیضی گون دارای سه محور اصلی a، d و c است که بسته به اندازه هر یک از محورها ویژگی های فیزیکی آن می تواند تغییر کند. حالتی که در این مقاله در نظر گرفته می شود مربوط به نانو ذره بیضوی کشیده در راستای قائم (Prolate) و پَخت (پهن شده) (Oblate). در نانو ذره کشیده

با دو محور یکسان نسبت $r = \frac{b}{a(=c)}$ مقداری بزرگتر از

¹ Shape factor

یک است که در این حالت فاکتور شکل به صورت تعریف میشود [۱۴و10].

$$\xi_{z} = \left(\frac{1-e^{\gamma}}{e^{\gamma}}\right)\left(-1+\frac{1}{\gamma e}\ln\frac{1+e}{1-e}\right),$$

$$\xi_{z} = \xi_{z} = \frac{1-\xi_{z}}{2}.$$
(a)

که $e^2 = 1 - \frac{1}{r^2}$, میباشد. همانطور که مشخص است به علت مساوی بودن دو محور a و c فاکتور شکل مربوط به محورهای مربوط نیز با هم برابر خواهند شد. در حالیکه برای نانو ذره پَخت ، مقدار r از کمتر از یک است و فاکتور شکل برای نانو ذره پَخت به صورت زیر به دست میآید. (۶) $\xi_z = (\frac{1+f^2}{f^2})(1-\frac{1}{f}\arctan f),$ (۶) $\xi_x = \xi_y = \frac{1-\xi_z}{f^2},$

که $1 - \frac{1}{r^2} = f$ است. با توجه به جهت میدان اعمال شده و شکل نانو ذره می توان عبارت مناسب را برای فاکتور شکل مورد استفاده قرار داد. شدت میدان هارمونیک دوم تولید شده توسط کوانتوم دات متناسب با مجذور دامنه میدان الکتریکی هارمونیک دوم است $(2^{qd}_{shg}) \propto (E^{qd}_{shg})$) که طبق معادله ۲ و عبارت مربوط به قطبش کوانتوم دات، این میدان نیز به عنصر ρ_{r_1} از عناصر ماتریس چگالی وابسته می باشد که باید آن را محاسبه کرد. برای محاسبه عنصر ρ_{r_1} ، با استفاده از معادله حرکت معادلات ماتریس چگالی دو فوتونی برای سیستم دو ترازه را بدست آورد و سپس با حل معادلات حرکت در حالت پایا ^۱ و بنابراین، با استفاده از معادله حرکت، معادلات ماتریس چگالی دو فوتونی سیستم دو ترازه عبارتند از:

$$\begin{split} \rho_{11} &= i\Lambda_{11}\rho_{11} - i\Lambda_{11}^{*}\rho_{11} + \gamma_{1}\rho_{11} \\ \cdot \\ \rho_{11} &= i\Lambda_{11}^{*}\rho_{11} - i\Lambda_{11}\rho_{11} - \gamma_{1}\rho_{11} \\ \cdot \\ \rho_{11} &= i\Lambda_{11}(\rho_{11} - \rho_{11}) + i\Delta\rho_{11} - i\Delta_{S}\rho_{11} - \frac{1}{\gamma}\gamma_{1}\rho_{11} \\ \cdot \\ \Delta_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{s} \left| \Omega_{11} \right| / \gamma_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{1} \\ \lambda_{S} &= \gamma \omega_{1} \\ \lambda_{S} &=$$

استارک^۲ است. ۲٫ نرخ واهلش ^۳ از تراز (۲|به تراز (۱) است $\Delta = \mathbf{Y} \omega - \omega_{\mathbf{r}_1}$ فركانس رابی δ میباشد. همچنین $\Omega_{\mathbf{r}_1}$ پارامتر نامیزانی بین گذار اتمی و فرکانس میدان کاوشگر در جذب دو فوتونی است. علاوه بر این، مىباشد كە از تركيب سە جملە $\Lambda_{\rm vr} = \Omega_{\rm rp} + \Omega_{\rm sh} + \Omega_{\rm ddi}$ $\Omega_{rp} = k_{lp} E_p^r / \tau \hbar \varepsilon_{eff}^r$ تشكيل شده است: جمله اول فرکانس رابی دو فوتونی ناشی از جذب مستقیم دو فوتون از ميدان كاوشگر توسط كوانتوم دات است، جملهٔ دوم فرکانس رابی ناشی از تاثیر میدانهای $\Omega_{sh} = \Omega_{sh}^{mnp_{i}} + \Omega_{sh}^{mnp_{i}}$ هارمونیک دوم نانو ذرات بر روی کوانتوم دات است و سومین هم کنش کوانتوم دات با میدان حاصل از دو قطبی های نانو ذرات است که این دو قطبی ها خود از سه میدان پروب ، میدان هارمونیک دوم و میدان دو قطبیهای کوانتوم دات تاثیر می پذیرد. از دو قسمت آخر می توان بعنوان جملات خود بر هم کنشی نام برد به $\rho_{r_1} = -i\Lambda_{r_1} / d_{r_1}$ با حل معادلات ۷ در شرایط پایا $\rho_{r_1} = -i\Lambda_{r_2} / d_{r_1}$ می آید که $\Lambda_{ii} = \Omega_{ii} + \Omega_{sh} + \Omega_{ddi}$ و است [۸۸و ۱۰] . $d_{_{
m Y}} = \gamma_{_{
m Y}} / \gamma - i \delta_{_{
m Y}} - i \Delta_{_{
m S}}$

۳. نتایج عددی و بحث

در این بخش نتایج عددی مربوط به شدت هارمونیک دوم تولید شده توسط کوانتوم دات در سیستم نا متقارن -MNP-SQD MNP را مورد بحث قرار گرفته و نشان داده می شود که چگونه ویژگیهای هندسی نانو ذرات و جهت قطبتی میدان فرودی اثر قوی روی شدت هارمونیک دوم دارد. فرض می شود که نانو ذرهها از جنس نقره است و ثابت دی الکتریک کوانتوم دات و دی الکتریک سیلیکا را به ترتیب ۶.۲۵ و ۲.۲۵ در نظر می گیریم. هم چنین شعاع کوانتوم دات ۳ نانومتر است. در نانو ذره کشیده محینین شعاع کوانتوم دات ۳ نانومتر است. در نانو ذره کشیده ، 2= r و در نانو ذره پَخت (پهن شده) ، 5.0= r اختیار شده است. همچنین نرخ واهلش $I = 1 \mu P$ و شدت میدان فرودی r = 0.5.

¹ Steady State Approximation

² Stark Frequency

³ Damping Rate

⁴ Rabi Frequency



محل ۲. سدی هارمونیک دوم تولیدهسته توسط توانیوم دان دوتوره وقتی نانوذرهها prolate هستند ، در دو حالت میدان فرودی موازی محور اصلی سیستم (نمودار آبی) و میدان فرودی حمود بر محور اصلی سیستم(نمودار قرمز).



شکل ۴. شدت هارمونیک دوم تولید شده توسط کوانتوم دات دوترازه وقتی دو نانو ذره فلزیoblate هستند در دو حالت میدان فرودی موازی محور اصلی سیستم (نمودار آبی) و میدان فرودی عمود بر محوراصلی سیستم است.

به علاوه اندازهٔ نانو ذرهها در حالت کشیده و پهن شده به ترتیب برابر

 $a_{1} = \Delta nm, b_{1} = 1 \cdot nm, a_{r} = 9nm, b_{r} = 17nm$ $a_{1} = 1 \cdot nm, b_{1} = \Delta nm, a_{r} = 17nm, b_{r} = 9nm$ فاصلهٔ سطح نانو ذره ۱ از سطح کوانتوم دات ۱۰ نانومتر و فاصلهی سطح نانوذره دوم از کوانتوم دات ۱۲ نانومتر اختیار شده است.

در شکل 3. نمودار تغییرات شدت هارمونیک دوم ناشی از کوانتوم دات به صورت تابعی از پارامتر نامیزانی برای نانوذره کشیده در حالتی که میدان فرودی موازی با محور اصلی سیستم است به رنگ آبی و درحالتی که عمود بر محور $(s_{\alpha}=\mathsf{r})$ اصلی سیستم ($s_{lpha}=-1$) است با رنگ قرمز کرسم شده است. همانطور که نتایج نشان میدهند در شرایطی که میدان به صورت عمود بر محور اصلي مي تابد شدت هارمونيک توليد شده ضعيف تر می شود. میدان های موثر بر کوانتوم دات حاصل برنهی میان میدان پروب خارجی و میدانهای القایی داخلی ناشی از بر هم کنش ها است. با توجه به شکل ۳ مشخص می شود که اگر جهت قطبش میدان فرودی عمود بر محور اصلی سیستم باشد شدت هارمونیک تولید شده کاهش یافته و پیک تشدیدی به سمت فرکانس های کوتاه تر میل میکند. در نتیجه تداخل بین میدان های اعمال شده بر کوانتوم دات ویرانگر است. در حالیکه اگر قطبش میدان فرودی موازی با محور اصلی سیستم باشد، شدت سیگنال توليد شده افزايش مي يابد.

در شکل ۴ ، هارمونیک دوم تولید شده توسط کوانتوم دات در دو حالت قطبش میدان فرودی موازی و عمود برمحور اصلی باشد در شرایطی که نانو ذرهها پَخت باشند در نظر گرفته شده است. همانطور که در این مورد نیز دیده می شود وقتی که قطبش میدان فرودی موازی با محور اصلی سیستم باشد شدت هارمونیک **د**وم بیشتر است. در شکل ۵ شدت هارمونیک تولید شده را برای کوانتوم دات در حالتی که شکل نانو ذرهها تغییر کند بررسی شده است و نتايج مقايسه شده اند .نتايج بدست أمده نشاب ميدهند كه وقتى نانوذره کشیده باشد (نمودار آبی) شدت هارمونیک تولید شده نسبت به حالتی که نانو ذره پَخت (نمودار قرمز) است افزایش یافته است. بنابراین در حالتی که یک کوانتم دات بین دو نانوذره فلزى كشيده بيضوى قرار داده مىشود نانو ذرههاى كشيده نسبت به حالتی که دو نانوذره يَخت (يهن شده) باشند، شدت هارمونیک دوم افزایش بیشتری را نشان میدهد. بنابراین، تولید هارمونیک دوم به شدت به جهت قطبش نور فرودی بستگی دارد [۱۹].

اصلى سيستم(نمودار قرمز).

برای درک بهتر رفتار سیستم در شکل ۶ فاکتور شکل برای نانو ذرات کشیده و پَخت (پهن شده) بر حسب مقدار مربوط به نسبت محورها رسم شده است . با توجه به اندازه ای که برای ابعاد نانو ذرهها در دو حالت کشیده و پخت اختیار کرده ایم نسبت محورها برای نانو ذره کشیده ۵. و برای نانو ذره پخت ۲ میباشد که همانطور که مشخص است فاکتور شکل در نانو ذره کشیده برای این نسبت محورها بین ۲. تا ۲. است در حالیکه این مقدار برای نانو ذره پخت از ۵. تجاوز میکند. بنابراین می توان دریافت که مقدار پارامتر شکل برای نانو ذره کشیده نسبت به فاکتور شکل نانو ذره پَخت (پهن شده) کشیده نسبت که منجر به ایجاد قطبش پذیری قویتر می شود . این بدین معنی است که نانو ذره کشیده منجر به ایجاد میدان پی دارد.

با محاسبهٔ شدت هارمونیک دوم تولید شده توسط کوانتوم دات در سیستم هیبریدی نالو ذره-کوانتوم دات-نانو ذره می توان نتیجه گرفت که دریک سیستم هیبریدی متشکل از دونانوذره فلزی جفت شده با یک کوانتم دات نیم رسانا وقتی میدان اعمال شده بر سیستم با محور اصلی آن موازی باشد تداخل بین میدان خارجی و میدانهای القایی داخلی از نوع سازنده و اگر عمود باشد از نوع ویرانگر است که همین سازنده با ویرانگر بودن تداخلها منجر به تقویت و تضعیف شدت میدان هارمونیک دوم گسیل شده از کوانتوم دات می شود. علاوه بر این، هنگامی که جهت قطبش نور تابشی موازی با محور سیستم طیف مشاهده می شود. علاوه بر این، شکل نانو ذرات پارامتر مهم دیگری است که شدت سیگنال هارمونیک دوم حساس به آن است. نتایج حاصل از این کار می تواند در طراحی افزارههای



شکل ۶. مقدار فاکتور شکل برای اندازههای مختلف محورها در الف) نانوذره پَخت (پهن شده) و ب)نانوذرهٔ کشده

مراجع

- 1. M Singh and C Racknor, JOSA B, vol. 32, No. 10 (2015).
- 2. W Yang, A Chen, Z Huang and R Lee, Optical Society of America, vol. 23, No. 10(2015).
- 3. J Yan, W Zhang, S Duan, X Zhao and A Gorov Physical review B 77, 165301 (2008).
- 4. Y He, J Li and K Zhu, J. Opt. Soc. Am, B vol. 29, No. 5 (2012)
- 5. R Artuso and G Bryant, Acta. Phys. Pol. A, Vol. 122, No. 2, 289 (2012).
- 6. M Anton, F Carreno, S Melle, O Calderon and E Cabrera, Phys. Rev. B 86, 155305 (2012).
- 7. H Akram, M Abdullah, A H.Al-khursan, Sci. Rep. vol. 12, 21495 (2022).
- 8. T Nakanishi, K Sugiyama amd M Kitano , Phys. Rev. A 67, 043809 (2003).
- 9. J Gondar, R Cipolatti and G Marques, Braz. J. Phys, vol. 36, No. 3B, 968 (2006).
- 10. M Singh, Nanotechnology 24, 125701 (2013).
- 11. R Boyed,"Nonlinear Optics", New York, USA (2008).
- 12. P Meystre and M SargentIII,"Element of Quantum Optics" (2007).
- 13. J David Jackson, "Classical Electrodynamics", Professor Emeritus of Physic, Berkeley, (1925).
- 14. D Sarid and W Challener,"Modern introduction to surface plasmons", Cambridge University press,(2010).
- 15. H.C Van de Hulst, "Light Scattering by Small Particle", Dover Publications, Inc. New York, (1981).
- 16. S Rand, "Nonlinear and quantum optics using the density matrix", OXFORD university press, (2010).
- 17. J. D. Cox, M. R. Singh, C. von Bilderling, and A. V. Bragas, Adv. Optical Mater. vol. 1, 460 (2013).
- 18. M Rashidi ,N Daneshfar, Eur. Phys. J. Plus, vol. 138, 765 (2023).
- 19. C. Hubert, L. Billot, P.-M. Adam, R. Bachelot, and P. Royer, J. Grand, D. Gindre, K. D. Dorkenoo, and A. Fort, Appl. Phys. Lett. vol. 90, 181105 (2007).